

強磁場による材料の組織と機能の制御

強磁場による鉄鋼中の粒界偏析と拡散制御

連川 貞弘

近年の研究により、磁場印加は材料の微細組織形成に関連するさまざまな金属学的現象に対して影響を及ぼ すことが明らかとなってきている、本解説においては、微細組織形成の素過程である拡散現象に対する磁場の 影響について述べるとともに、磁場を用いた粒界偏析および偏析脆化の抑制に関する研究成果を紹介したい、

はじめに

多結晶材料の諸性質は、Hall-Petchの関係に代表 されるように、粒界の存在に著しく影響されること が1950年代より知られている¹⁾²⁾. 1960年代初頭か らの双結晶を用いた多くの基礎的研究より、粒界の 諸特性は個々の粒界の性格・構造に依存することが 実証されてきた^{3)~5)}. 1980年代初頭に、基礎的知見 をもとに「粒界設計・制御にもとづく材料開発」と いう概念が提唱され⁶⁾⁷⁾、現在の「粒界工学」という 分野へ発展してきており、粒界のもつ重要性、多様 性が材料設計開発に応用されてきている.

バルクとしての多結晶材料の特性は、多結晶を 構成する結晶粒のイントリンシックな特性による ばかりでなく、多様な性質をもつ粒界の集合的影 響の結果として現れる.したがって、多結晶材料の 材料設計においては粒界微細組織を定量的に評価 することが不可欠である.これまで、結晶粒径(す なわち、粒界密度)、粒方位分布(集合組織)という 因子がしばしば評価されてきたが、個々の粒界の 特性の相違までは考慮されていなかった.1980年 初頭に、今日では広く認められてきている「粒界性 格分布」という組織因子が導入され⁸⁾、バルクの諸 特性との関連が検討された結果、多結晶材料の特 性が粒界性格分布に著しく依存することが明らか となってきた⁹⁾. 1990 年代後半には「粒界性格分 布」の制御を通して、例えば、原子炉材料Alloy 600 の耐応力腐食割れ¹⁰⁾¹¹⁾および耐クリープ特性¹²⁾や 鉛蓄電池用電極の耐応力腐食割れ¹³⁾, さらにはFePd 合金の磁歪特性^{14) 15)} が飛躍的に向上すること が実証された.その結果,先端材料の設計・開発に おける「粒界工学」という新しい分野が注目され, 今日に至っている.

これまでに、粒界微細組織は材料の作製プロセ スに著しく依存することが明らかにされてきた¹⁶⁾. 多結晶材料に望みの特性を発現させるために粒界 微細組織をいかに制御するかは工学的に重要な課 題である. 従来、金属材料の微細組織制御には主に 加工熱処理法が利用されてきた. 磁場、電場などの 「外場」の材料プロセスへの積極的応用は微細組織 をさらに精密に制御し、新機能を創生するための 手法として、高い可能性を秘めている.

磁場に関しては、1913年にPenderとJones¹⁷⁾が, 低炭素鋼のパーライト変態時に交流磁場を印加す ることによりパーライト組織が微細化し均質な組 織が得られることを報告して以来,再結晶^{18)~22)}, 析出^{23) 24)},規則化²⁵⁾,相変態^{26)~30)},粒成長³¹⁾, 粒界移動^{32)~35)}などさまざまな金属学的現象に対 して磁場が影響を与えることが明らかにされてき ており,磁場作用を利用した微細組織制御に関す る研究が精力的に進められている.本報において は,我々の最近の研究の中から,磁場作用による粒 界偏析の抑制効果と微細組織形成の素過程である 拡散に及ぼす磁場の影響について紹介したい.

Fe-0.8at%Sn 合金の粒界偏析 および偏析脆化の磁場による制御

資源の有効利用,環境保護の面から,使用済み材

料,特に鉄鋼材料のリサイクルは,国家的および世 界的規模で重要な課題となっている.しかし,市場 から回収される自動車などのスクラップには,鉄 鋼材料の熱間加工性を劣化させる銅や焼戻し脆性 の原因となる錫などの不純物が混入し,鉄鋼材料 の特性劣化をももたらす.したがって,リサイクル に係わる有害元素の無害化技術の開発が緊急課題 となってきている.

リサイクルにともなう材料特性劣化は, リサイ クルに際して外部から入り蓄積される有害微量元 素の粒界偏析(表面偏析を含む)あるいはこれらの 元素を含んだ第二相の粒界析出に起因する. 特に 鉄鋼材料では, Sn, P, S, Cu等が微量に存在すると 顕著な脆性を示す. これらの元素は鉄に対する固溶 度が非常に低いため, 粒界に偏在し, 母相における 固溶度の100倍から1万倍も粒界に富化されること による. SeahとHondrosのオージェ電子分光法を用 いた系統的な研究から, 粒界富化率が固溶度と逆比 例の関係にあることが見出され, 固溶度の小さい元 素ほど粒界偏析が顕著に起こることが明らかにされ ている³⁶⁾. したがって, 固溶度の低い Sn, P, Cu 等 の有害元素ほど粒界に顕著に富化され, 多結晶材料 のバルク特性に大きな影響を及ぼすことになる.

粒界偏析の制御

最近,筆者らは直流磁場作用により鉄中のSnの 粒界偏析が抑制されることを見出した³⁷⁾³⁸⁾.この ことは,磁場中焼鈍が,鉄鋼リサイクル材料の粒界 偏析脆化の制御方法として有効な方法となりうる ことを期待させる.図1は,Fe-0.8at%Sn合金の粒 界エネルギーと磁場強度との関係を示したもので ある.個々の粒界の性格の相違に起因してデータ のばらつきはあるが,磁場強度の増加とともに,粒 界エネルギーが大きくなる傾向があることがわか る.SeahとHondros³⁶⁾は,Gibbsの表面吸着理論に もとづき,希薄二元系合金における粒界エネル ギーγと溶質原子濃度 X_c および粒界における溶 質原子の単位面積あたりのモル量 Γ との間に次の 関係があることを明らかにしており,

$$\Gamma = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\partial \gamma}{\partial \ln X_c} \right)_{T,V}$$
(1)



図1 磁場中焼鈍 (H=6T) された Fe-0.8at% Sn 合金の粒 界エネルギーの磁場強度依存性³⁸⁾. 粒界エネルギーは表 面エネルギーで規格化されてある.



図2 Fe-0.8at%Sn 合金中のランダム粒界について粒界 に垂直な方向に沿って測定された Sn 濃度分布.

Fe-Sn合金の粒界エネルギーはSnの粒界偏析量の 減少と共に高くなることを報告している.した がって,図1の結果は,直流磁場の印加によりSn の粒界偏析が抑制されることを示唆している.

図2は、973Kで6時間、3T(テスラ)の磁場中お よび無磁場焼鈍されたFe-0.8at%Sn合金試料中の ランダム粒界について、粒界に垂直な方向に沿っ て測定されたSn濃度の分布を示している.無磁場 焼鈍試料においては、ランダム粒界におけるSnの 濃度は粒内よりも1.5倍程度高く、明らかにSnの 粒界偏析が生じていることがわかる.これに対し、 3Tの磁場作用下で焼鈍された試料においては、ラ ンダム粒界上と粒内におけるSn濃度はほぼ等し く、磁場作用によりFe-Sn合金におけるSnの粒界



図3 磁場中焼鈍 (*H*=6T) された Fe-0.8at % Sn 合金のランダム粒界における Sn 濃度と焼鈍中に印加した磁場強度との関係³⁸⁾.

偏析が抑制されていることを示している.

図3は、磁場印加方向に対して垂直なランダム 粒界についてエネルギー分散型X線分光(EDS)測 定を行った結果から、Feに対するSnの特性X線の 強度比を、印加磁場強度の関数として示したもの である、磁場強度の増加とともにSn/Fe強度比が 低下し、3T以上の磁場の印加により、粒内部と同レ ベルまでSn/Fe強度比が低下することがわかる。

偏析脆化の制御

次に、Fe-Sn合金の粒界偏析脆性が磁場中焼鈍に より抑制されるか否か調査を行った.図4は磁場 中焼鈍されたFe-Sn合金の温度77Kにおける破壊 靭性値を焼鈍中に印加した磁場強度に対してプ ロットしたものである.比較のために、図4には異 なる粒径をもつ純鉄の破壊靭性をグラフの右側縦 軸に矢印で示した.いずれのFe-Sn合金において も、破壊靭性値が直流磁場強度の増加とともに大 きくなることがわかる.一般に、破壊靭性は結晶粒 径および粒界性格分布に依存するものであるが、 本実験では磁場中および無磁場焼鈍されたFe-Sn 合金試料の粒径および粒界性格分布には大きな相 違はなかった.そのことから、磁場中焼鈍による破 壊靭性値の増加は、磁場印加によって粒界偏析が 抑制された結果であると結論される.

図5は、磁場中および無磁場中焼鈍されたFe-0.8at%Sn合金を室温において3点曲げ試験を行っ た際の応カーひずみ曲線である. 無磁場焼鈍され



図4 磁場中焼鈍(T=973K,6h)されたFe-Sn合金の77K (液体窒素温度)における破壊靭性値と焼鈍中に印加し た磁場強度との関係³⁸⁾.



図5 磁場中および無磁場焼鈍された Fe-0.8at% Sn 合金 の室温における応力-ひずみ曲線³⁸⁾.

た試料は室温においてもほとんど塑性変形をする ことなく破壊している.これに対して,磁場中焼鈍 された試料は明らかに塑性変形することがわかる. 装置の関係上,磁場中焼鈍された試料に対する3 点曲げ試験は,0.6%ひずみまでしか行わなかった が,これらの結果からも,磁場中焼鈍がFe-Sn合金 の粒界偏析脆化の抑制に有効であることがわかる.

以上述べてきたように, Fe-Sn 合金中の Sn の粒 界偏析が磁場作用により抑制され, 偏析脆化を制 御できることを明らかにしてきた. このような磁 場作用による粒界偏析の抑制効果がSn以外の元素 についても有効であるのか否か, 現在さらに研究 を進めているところである.

磁場中における固体内の拡散

均一磁場中における拡散

材料の微細組織形成に関連する多くの現象は 「拡散」を素過程とする現象であり、磁場プロセス の確立のためには拡散に及ぼす磁場の影響を明ら かにすることが不可欠である.残念ながら、拡散 に対する磁場の影響に関する報告は少ない. 例え ば, Youdelis らは, 3Tの磁場作用下において. Al中 のCuの拡散が抑制されることを報告している³⁹⁾. これに対し、Nakajimaらは、4Tの磁場中において Ti中のNiの拡散はほとんど磁場の影響を受けない と報告している⁴⁰⁾. さらに, Pokoevら⁴¹⁾, Mironov ら⁴²⁾は、0~0.7Tの比較的弱い磁場中においてFe. CoおよびFe-Si合金におけるニッケルの拡散につい て測定を行い、Niの拡散は磁場強度に依存して促進 あるいは抑制されることを報告している. このよう に、これまでに報告されている磁場中の拡散に関す る実験結果は、整合しているとは言いがたい.

鉄中の炭素の拡散

磁場プロセスにおいて最も興味ある対象材料で ある鉄鋼材料の組織形成に最も深く関与する鉄中 の炭素の拡散に対してはこれまで全く研究例がな かった.

図6は6Tの均一磁場作用下および無磁場中に おけるγ鉄⁴³⁾ および α 鉄⁴⁴⁾ 中の炭素の拡散係数 を温度の逆数に対してプロットしたものである. なお,図6には45T/mの磁場勾配下における拡散 挙動も併記されているが,磁場勾配の結果につい ては後述する.図6より,6Tの均一磁場下におい て α 鉄および γ 鉄いずれにおいても炭素の拡散が 抑制されることがわかる.磁場による拡散の抑制 効果は,キュリー温度以下の α 鉄の方が常磁性の γ 鉄より顕著である.すなわち,6Tの均一磁場中にお



図6 無磁場および均一磁場(H=6T),磁場勾配(45T/m) 作用下における鉄中の炭素の拡散係数の温度依存性.

ける拡散係数の減少率は, α鉄で68%, γ鉄で38% である、一方、炭素の拡散の活性化エネルギーは、 磁場印加の有無にかかわらず, α 鉄中において約 115kI/mol. ?鉄中において約150kI/molと明瞭な 相違は認められなかった. これらのことより, 鉄中 の炭素の拡散に対する磁場の効果は、拡散の活性 化エネルギーではなく,振動数項(前指数項)に影 響を及ぼすことがわかる. そこで炭素の拡散の物 理モデルを構築し、数値解析を行った結果,均一磁 場作用下においては炭素の配置エントロピーが拡 散抑制に重要な役割を果たしていることが示唆さ れている44),一方,図7は鉄中のチタンの拡散に およぼす磁場の影響について調べた結果であるが. 炭素の拡散とは異なり、チタンの拡散に対しては 磁場の影響はほとんど認められない43).鉄中の炭 素およびチタンの拡散はそれぞれ、侵入型拡散機 構および空孔型拡散機構であることを考えると, 以上の結果は、鉄中の原子の拡散に対する磁場の 影響は拡散機構に依存することを示唆している.



図7 無磁場および均一磁場(H=6T),磁場勾配(45T/m)作 用下における y鉄中のチタンの拡散係数の温度依存性⁴³⁾.

磁場勾配中における拡散

前節では均一磁場中における拡散現象について 述べてきた.以下では、磁場の強度が連続的に変化 している、すなわち、磁場勾配下における拡散挙動 について述べる.

図6に示したように、均一磁場下における拡散 とは逆に、45T/mの磁場勾配下(この場合、炭素原 子の拡散方向を負方向とすると、負の磁場勾配が作 用している.すなわち、磁場強度が高くなる方向に 炭素が拡散する)においては、α鉄およびγ鉄いず れにおいても炭素の拡散が促進される.また、図8 に示すように、磁場勾配強度が大きくなるにつれ て拡散の促進の度合いが大きくなること、逆に、正 の磁場勾配下(磁場強度が低くなる方向に炭素が 拡散する)では、無磁場中の拡散係数よりもわずか に小さくなる.

磁場のような外場の勾配が作用している環境下 においては、原子の拡散に対する Fick の第一法則 は次式で与えられる.

$$J = -D\left(\frac{dC}{dx} + \frac{C}{kT}\frac{dU}{dx}\right) \tag{2}$$

H(dH/dx) (10² T²m⁻¹) 10-10-0 0.5 1.0 1.5 2.0 温度:1223K **拡散係数, D (m²s⁻¹)** 無磁堤 正の磁場勾配 $6T_0T/m$ 10-1 30 10 20 40 50 磁場勾配強度, dH/dx (Tm⁻¹)

図8 温度1223Kにおけるγ鉄中の炭素の拡散係数に及 ぼす磁場勾配の効果.□は負の磁場勾配強度依存性.▲ は逆の(正)の磁場勾配作用下における結果.なお,炭素 原子の拡散方向を負の方向としてある.⁴³⁾

ここで, *dC/dx* は濃度勾配, *C*は濃度, *dU/dx* はポ テンシャル勾配, *J*, *D*, *k*, *T* は通常の意味である. また, 単位体積あたりの強磁性材料の磁気自由エ ネルギーは,

$$U_{\rm f} = -\mu_0 \left(H - \frac{NM_s}{2} \right) M_s \tag{3}$$

で与えられる.ここで, μ_0 は真空の透磁率, M_s は 飽和磁化,Hは磁場強度,Nは反磁場係数である. いま,反磁場の影響を無視すると,式(2),(3)より,

$$J = -D\left(\frac{dC}{dx} - \mu_0 M_s \frac{C}{kT} \frac{dH}{dx}\right) \tag{4}$$

μ₀, *M*_sは正の値であるので,したがって,負の磁場 勾配下においては拡散が促進されることになる. なお,式(4)では,拡散係数は磁場勾配強度に依存 しないが,本研究における解析においては,式(4) の右辺第2項に示された,拡散の駆動力として作 用するポテンシャル勾配(磁場勾配)の効果が,見 かけ上,拡散係数の変化として測定されているこ とを付記しておきたい.

おわりに

本報では,最近の筆者らの研究から,粒界偏析と 拡散現象に対する磁場作用の効果について紹介し てきたが,これらの効果の起源について十分理解 されているわけではない.今後さらに実験・理論両

金属 Vol.80 (2010) No.5

面より研究を進め,磁場効果の物理的起源を明ら かにしていかなければならない.紙面の都合上,説 明が十分でないところも多いが,参考文献等を参 照して補足していただければ幸甚である.読者の 皆様に少しでも磁場作用を利用した微細組織制御, 粒界工学について興味を持っていただけたらと願 いながら筆をおきたい.なお,本研究は科学研究費 補助金基盤研究(S)(19106013)により行われたも のであることを付記し,感謝の意を表したい.

参考文献

- 1) E. O. Hall: Proc. Phys. Soc., Lond., B64 (1951), 747.
- 2) N. J. Petch: J. Iron Steel Inst., 174 (1953), 25.
- G. Gleiter and B. Chalmers: High Angle Grain Boundaries, Pergamon Press, (1972).
- G. A. Chadwick and D. A. Smith (ed.): Grain Boundary Structure and Properties, Academic Press, (1976).
- 5) Y. Ishida (ed.): Grain Boundary Structure and Related Phenomena, Suppl. Trans., JIM, **27** (1986).
- 6) 渡辺忠雄:日本金属学会会報, 22 (1983), 95.
- 7) T. Watanabe: Res Mechanica, **11** (1984), 47.
- T. Watanabe, N. Yoshikawa and S. Karashima: Proc. 6th Intern. Conf. on Textures of Materials (ICOTOM-6), Japan Iron Steel Inst., (1981), 609.
- U. Erb and G. Palumbo: Grain Boundary Engineering, Canadian Inst. Mining, Metallurgy and Petroleum, (1993)
- G. Palumbo et al.: MRS Conf. Proc. (Interfacial Engineering for Optimized Properties), 458 (1997), 573.
- G. Palumbo, E. M. Lehockey, P. Lin: JOM, 50 No.2 (1998), 40.
- 12) V. Thaveeprungsriporn and G. S. Was: Metall. Trans. A, **28A** (1997), 2101.
- E. M. Lehockey, G. Palumbo, P. Lin and A. Brennenstuhl: Metall. Trans. A, 29A (1998), 387.
- Y. Furuya, N. W. Hagood, H. Kimura and T. Watanabe, Mater. Trans., JIM, 39 (1998), 1248.
- T. Watanabe and S. Tsurekawa: Acta Mater., 47 (1999), 4171.
- T. Watanabe: Texture and Microstructures, 20 (1993), 195.
- 17) H. Pender and R. L. Jones: Phys. Rev., 1 (1913), 259.
- R. Smoluchowski and R. Turner: J. Appl. Phys., 20 (1949), 745.
- H. O. Martikainen and V. K. Lindroos: Scandinavian J. Metallurgy, 10 (1981), 3.
- T. Watanabe, Y. Suzuki, S. Tanii and H. Oikawa: Phil. Mag. Lett., 62 (1990), 9.

- N. Masahashi, M. Matsuo and K. Watanabe: J. Mater. Res., 13 (1998), 457.
- 22) T. Watanabe: Proc. 4th Inter. Conf. on Recrystallization and Related Phenomena (JIMIS-10), The Japan Institute of Metals, (1999), 99.
- 23) G. Sauthoff and W. Pitsch: Phil. Mag. B, 56 (1987), 471.
- 24) 藤居俊之,小野亨,加藤雅治:日本金属学会誌.,61 (1997),267.
- 25) 大嶋隆一郎,所久人:日本金属学会誌., 62 (1998), 317.
- 26) J. W. Cahn: J. Appl. Phys, 34 (1963), 3681.
- T. Kakeshita, H. Shirai, K. Shimizu, K. Sugiyama, K. Hazumi and M. Date: Trans. JIM, 28 (1987), 89.
- 28) T. Kakeshita, T. Saburi, K. Kindo and S. Endo: Jpn. J. Appl. Phys., 36 (1997), 7083.
- H. Ohtsuka, Y. Xu and H. Wada: Mater. Trans., JIM, 41 (2000), 907.
- M. Shimotomai and K. Maruta: Scripta Mater., 42 (2000), 499.
- K. Harada, S. Tsurekawa, T. Watanabe and G. Palumbo: Scripta Mater., 49 (2003), 367.
- 32) D. A. Molodov, G. Gottstein, F. Heringhaus and L. S. Shvindlerman: Scripta Mater., 37 (1997), 1207.
- 33) D. A. Molodov, G. Gottstein, F. Heringhaus and L. S. Shvindlerman: Acta Mater., 46 (1998), 5627.
- 34) A. D. Sheikh-Al, D. A. Molodov and H. Garmestani: Scripta Mater., 48 (2003), 483.
- 35) S. Tsurekawa, K. Inoue and P. Lejcek: ISIJ International, **50** (2010), 591.
- 36) M. P. Seah and E. D. Hondros, Proc. Roy. Soc., A335 (1973) 191.
- 37) S. Tsurekawa, K. Kawahara, K. Okamoto, T. Watanabe and R. Faulkner: Mater. Sci. Eng. A, 387-389 (2004), 442.
- 38) S. Tsurekawa, K. Okamoto, K. Kawahara and T. Watanabe: J. Mater. Sci., 40 (2005), 895.
- 39) W. V. Youdelis, D.R. Colton and J. Cahoon.: Can. J. Phys., 42 (1964), 2217.
- 40) H. Nakajima, S. Maekawa, Y. Aoki and M. Koiwa: Trans. Jpn. Inst. Met., 26 (1985), 1.
- A. V. Pokoev, D. I. Stepanov, I. S. Trofimov and V. F. Mazanko: Phys. Stat. Sol.(a), 137 (1993), K1.
- 42) A. V. Mironov, A. V. Pokoev, D. I. Stepanov and I. S. Trofimov: Defect, Diffusion Forum, 194-199 (2001), 67.
- S. Nakamichi, S. Tsurekawa, Y. Morizono, T. Watanabe, M. Nishida and A. Chiba: J. Mater. Sci., 40 (2005), 3191.
- 44) 藤井啓道:東北大学博士論文,(2009).

つれかわ・さだひろ TSUREKAWA Sadahiro

1990 九州大学大学院総合理工学研究科博士後期課程修了. 同年 九州大学大学院総合理工学研究科助手, 1997 東北大学大学院工 学研究科助教授, 現在 熊本大学大学院自然科学研究科教授. 専 門:材料界面物性学, 粒界工学.